断裂力学 第三次作业答案

1、下表为一些金属的解理面及解理正应力,请归纳出几条规律,并作简要阐述。

金 属	晶体结构	解理面	试验温度/℃	解理临界正应力/MPa
w	体心立方	(100)		
α - Fe	体心立方	(100)	-100	254. 8
			-185	269.5
Zn	密排六方	(0001)	-185	1.76~1.96
Zn(0, 03%Cd)		(0001)	-185	1.86
		(1010)	-185	17.64
Zn(0, 13%Cd)		(0001)	-185	2.94
Zn(0, 53%Cd)		(0001)	-185	11.76
Mg	密排六方	(0001),(1011)		
	III WE ALL	$(10\overline{1}2),(10\overline{1}0)$		
Te	密排六方	(1010)	20	4. 21
Sb	菱方	(111)	20	6.47
Bi	菱方	(111)	20	3.14

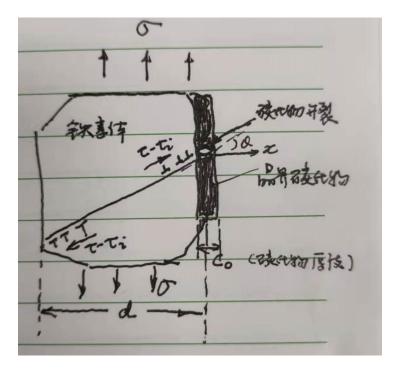
答: (1) 从晶体结构的角度看,在金属的三种典型结构,即面心立方(fcc)、体心立方(bcc)和密排六方(hcp)中,只有 bcc 和 hcp 结构的金属可能发生解理断裂,而 fcc 结构的金属一般不会发生解理断裂。(2) 从晶体学角度看,解理面一般含低指数晶面。对于 bcc 结构,解理面为{100}晶面族;对于 hcp 结构,解理面一般为{0001}晶面族,但当轴比 c/a 合适时,有时也可能产生柱面解理。(3)对于 bcc 和 hcp 结构,解理发生在室温(20°C)以下的较低温度区间,只有复杂结构,例如 Sb 和 Bi 可能在室温发生解理断裂,因此 bcc 和 hcp 结构的金属具有明显的低温脆性。(4) bcc 结构金属相比于 hcp 结构的金属具有较高的解理断裂强度,表明 hcp 金属更容易发生解理断裂,比 bcc 金属的脆性更大。

2、在特定场合下,铁素体钢也会发生解理断裂,它是由于位错滑移受到晶界碳化物阻碍而塞积在碳化物前,高的应力集中导致碳化物开裂,形成解理裂纹,并最终断裂。请利用位错塞积群理论和Griffith断裂条件,证明解理裂纹形核时作用在位错塞积群上的临界名义剪应力为:

$$\tau_c \,=\, \tau_i \,+\, \sqrt{3E\gamma_C}\,\cdot\, d^{-\frac{1}{2}}$$

式中, τ_i 为位错滑移的点整摩擦阻力; E为杨氏模量、 γ_c 为碳化物比表面能; d为晶粒直径。

答:位错塞积于晶界碳化物的模型如图所示,根据位错塞积群理论,位错塞积群前方 r 距离点的应力为 $\tau_{r,\theta}=(\tau-\tau_i)\sqrt{\frac{d}{2r}}$,因解理裂纹是在拉应力下形核的,则在位错头部(r,θ)点的周向应力为 $\sigma_{r,\theta}=\frac{3}{2}(\tau-\tau_i)\sqrt{\frac{d}{2r}}sin\theta cos\frac{\theta}{2}$,令 $\frac{\partial\sigma_{r,\theta}}{\partial\theta}=0$,可解得 $cos\theta=\frac{1}{3}$,即 $\theta=70.5^\circ$ 时,周向应力达到最大 $\sigma_{\theta max}=\frac{2}{\sqrt{3}}(\tau-\tau_i)\sqrt{\frac{d}{2r}}$,取 $r=c_0$,得 $\sigma_{\theta max}=\frac{2}{\sqrt{3}}(\tau-\tau_i)\sqrt{\frac{d}{2c_0}}$,当此正应力达到 Griffith 应力时,碳化物断裂形成解理裂纹,因 $\sigma_{Griffith}=\sqrt{\frac{2E\gamma_c}{c_0}}$,因此 $\frac{2}{\sqrt{3}}(\tau-\tau_i)\sqrt{\frac{d}{2c_0}}=\sqrt{\frac{2E\gamma_c}{c_0}}$,即可解得 $\tau_c=\tau_i+\sqrt{3E\gamma_c}\cdot d^{-\frac{1}{2}}$,证毕。

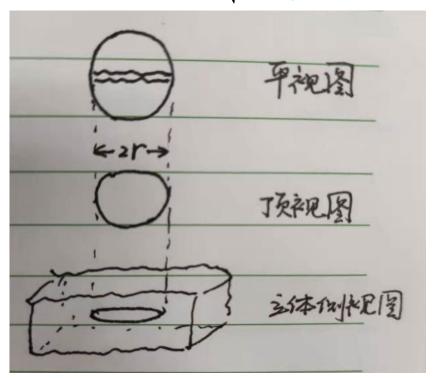


3、对于常用工程金属材料,在室温下最常发生微孔聚集型韧性断裂,微孔萌生有"颗粒/基体界面脱粘"及"颗粒本身碎断"两种可能的方式。假设在某一特定情况下夹杂物颗粒碎断,形成半径为r 的钱币状微裂纹(应力强度因子表达式为: $K=\frac{2}{\pi}\,\sigma\sqrt{\pi r}$),试证明微孔形核的临界应力为:

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{3E\pi\Gamma_s}{8(1-v^2)R_0}}$$

式中,E为基体杨氏模量;v为基体泊松比; R_0 为夹杂物颗粒半径; Γ_s 为颗粒自由比表面能。

答:以颗粒碎断方式形成的微孔可以近似为钱币状裂纹,在断裂力学中可以作为 "无限大体内内埋圆盘裂纹受单向拉伸"的问题,如右图所示,此裂纹顶端的应力强度因子为 $K=\frac{2}{\pi}\sigma\sqrt{\pi r}$,在平面应变状态下,裂纹扩展能量释放率 G 与应力强度因子 K 的关系为 $G=\frac{1-\nu^2}{E}K^2$,由此可得 $G=\frac{4(1-\nu^2)}{\pi E}\sigma^2 r$,在颗粒中平面上形成一个钱币状裂纹所需要释放的能量为 $\Delta U_e=\int_0^{R_0}G2\pi rdr=\frac{8}{3}(1-\nu^2)\frac{\sigma^2}{E}R_0$,相应地,形成裂纹表面增加的表面能为 $\Delta U_s=\pi R_0^2\Gamma_s$,根据能量平衡原理应有 $\Delta U_e=\Delta U_s$,可以得到颗粒碎断的临界应力 $\sigma_c=\sqrt{\frac{3E\pi\Gamma_s}{8(1-\nu^2)R_0}}$



4. 请简要阐述解理断裂和微孔聚集型断裂在宏观表现、微观机制、以及断口等方面的差异。

4. 答:(1)宏观表现。	解理断裂	做孔聚集断裂
かる田銭	₹ × v	
强度	9403	好>55
塑性	伍	高
韧性	纸	亳
(2) 独观机制		
製級形核地点	、	夹杂物,第二种颗粒
裂级形核方式	不均均滑移产生的	界面脫粘或
***	高应力集中导致沿	颗粒碎断.
	解理面拉开	
夏奴扩展方式	裂尖前原3键层	微孔横向扩张
	"接力传递或拉开	聚台
黎钦扩展速度	失恐扩展	有一个亚稳态阶段
	接近声速	
(3) 断り		
宏观、断口	杯链状(拉伸时)	结晶状
	区: 纤维区、放射区、剪切	唇 放射状
微观断口	初富	河流花样
		解理的所

答:

5. 简要阐述位错在断裂过程(包括裂纹形核及裂纹扩展两个阶段) 中所起的作用。

答: (1)在裂纹形核中所起的作用: ①对于脆性解理断裂: 位错的不均匀滑移导致局部区域高度应力集中, 引发微裂纹形核。常是三种机制: (a) stroh 位错塞积机制: 位错运动遇到晶界等强障碍, 在障碍前塞积成位错群, 由于塞积群头部的高应力集中而形成微裂纹。(b) Cottrell 位错反应机制: 不同滑移面上的运动位错相遇后, 在满足结构条件和能量条件的情况下发生位错合成反应, 形成新的固定位错。随着固定位错增多, 发生高应力集中, 形成微裂纹。(c) smith 硬化物

唇裂机制: 位错滑移遇到晶界上的碳化物而塞积, 高应力集中导致碳化物开裂, 成为解理微裂纹核心。②对韧性微孔聚集型断裂: (a) 对高纯度单晶体: 随着塑性变形的发展, 位错增殖, 位错间交互作用变得强烈, 在位错缠绕严重区域形成微孔洞。(b) 对工程金属材料: 位错在第二相颗粒处塞积, 使基体与颗粒的变形严重失配(因颗粒只发生弹性变形而不发生塑性变形), 导致应力的不均匀分配, 可引起颗粒与基体产生界面脱粘或颗粒本身碎断, 形成微孔洞。

(2) 在裂纹稳态扩展中所起到的作用: ①位错在裂纹尖端发射, 使裂纹尖端钝化, 且在裂纹尖端前沿产生塑性区, 吸收塑性变形功, 从而障碍裂纹扩展, 使韧性提高(从物理机制角度)②位错应力场导致裂纹尖端区域的应力强度因子 K 下降(即位错有屏蔽作用), 降低裂纹尖端应力集中程度, 使裂纹扩展驱动力降低(从力学角度)。